

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2007年11月22日 (22.11.2007)

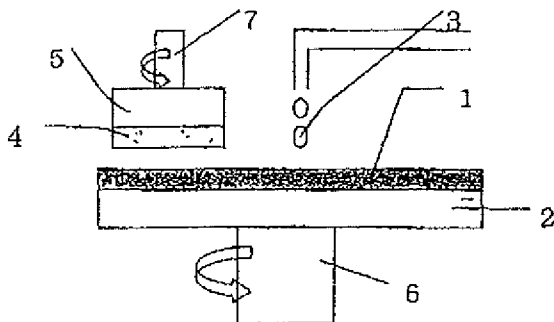
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/132855 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/04 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/059970
- (22) 国際出願日: 2007年5月15日 (15.05.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-137356 2006年5月17日 (17.05.2006) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋ゴム工業株式会社 (TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 福田 武司 (FUKUDA, Takeshi) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 廣瀬 純司 (HIROSE, Junji) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 中井 良之 (NAKAI, Yoshiyuki) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 木村 毅 (KIMURA, Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 尾崎 雄三, 外(OZAKI, Yuzo et al.); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目13-9 新大阪MTビル1号館 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド



wavelength range of 300 to 400 nm.

(57) Abstract: This invention provides a polishing pad, which has an excellent optical detection accuracy in a broad wavelength range (particularly on a short wavelength side), and a method for manufacturing a semiconductor device, comprising the step of polishing the surface of a semiconductor wafer with the polishing pad. The polishing pad comprises a polishing layer including a polishing region and a light transmission region and is characterized in that the light transmission region is formed of a polyurethane resin having an aromatic ring concentration of not more than 2% by weight and the light transmittance in the light transmission region is not less than 30% in the whole

(57) 要約: 広い波長範囲 (特に短波長側) で光学的検知精度に優れる研磨パッドを提供することを目的とする。また、該研磨パッドを用いて半導体ウエハの表面を研磨する工程を含む半導体デバイスの製造方法を提供することを目的とする。研磨領域及び光透過領域を含む研磨層を有する研磨パッドにおいて、前記光透過領域は、芳香環濃度が2重量%以下のポリウレタン樹脂からなり、かつ前記光透過領域の光透過率は、波長300~400nmの全範囲で30%以上であることを特徴とする研磨パッド。

WO 2007/132855 A1